

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第1区分
 【発行日】令和4年10月31日(2022.10.31)

【公開番号】特開2021-103104(P2021-103104A)
 【公開日】令和3年7月15日(2021.7.15)
 【年通号数】公開・登録公報2021-031
 【出願番号】特願2019-233959(P2019-233959)
 【国際特許分類】

G 2 1 K 5/08(2006.01)
 H 0 5 H 6/00(2006.01)
 H 0 5 H 3/06(2006.01)
 C 2 3 C 14/06(2006.01)
 C 2 3 C 14/14(2006.01)
 C 2 3 C 16/06(2006.01)

10

【F I】

G 2 1 K 5/08 N
 H 0 5 H 6/00
 H 0 5 H 3/06
 C 2 3 C 14/06 N
 C 2 3 C 14/14 D
 C 2 3 C 16/06

20

【手続補正書】

【提出日】令和4年10月21日(2022.10.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板上に形成されるリチウム層、

前記リチウム層の上に形成される金属クロム層と、

前記金属クロム層上に形成される傾斜窒化クロム層と、を有する中性子発生用リチウムターゲット。

【請求項2】

前記リチウム層と、前記金属クロム層の間に、酸素を含む中間層を備える請求項1記載の中性子発生用リチウムターゲット。

40

【請求項3】

前記基板は、高純度銅によって構成される請求項1記載の中性子発生用リチウムターゲット。

【請求項4】

基板上にリチウム層を形成する工程、

前記リチウム層上に金属クロム層を形成する工程、

前記金属クロム層上に傾斜窒化クロム層を形成する工程、を備える中性子発生用リチウムターゲットの製造方法。

【請求項5】

前記リチウム層を形成する工程と前記リチウム層上に金属クロム層を形成する工程の間

50

に、酸素濃度を 2×10^{-6} to 1 以上 2×10^{-4} to 1 以下の範囲とする請求項 4 記載の中性子発生用リチウムターゲットの製造方法。

10

20

30

40

50